

ПЛАН на выполнение НИР «Исследование терагерцового и инфракрасного детектирования в туннельных транзисторах на основе графена»

1. Исследования зависимостей фототока от напряжения на затворе, температуры и длины волны излучения в транзисторах на основе двухслойного графена с натуральным краем и малым (~30 нм) расстоянием сток-затвор.

2. Исследование зависимостей фототока от напряжения на затворе, температуры и длины волны излучения в транзисторах на основе двух слоев графена, разделенных туннельно-прозрачным диэлектриком – нитридом бора.

**Список оборудования и перечень услуг ЦКП ИФМ РАН для выполнения НИР «Исследование фотовольтаического эффекта и фотопроводимости в вертикальных туннельных транзисторах на основе графена»**

п/п	Наименование используемого Оборудования ЦКП ИФМ РАН	Пункт из перечня услуг(работ), указанного на сайте	Наименование работы	Стоимость работ 1час (в руб)	Расчетное время работ (в час)	Цена работы ( в руб)
1	Фурье-спектрометр BRUKER Vertex 80V	п.20	Регистрация спектров пропускания, отражения и фотопроводимости различных материалов методом Фурье-спектроскопии высокого разрешения с интерпретацией результатов (T=300K)	2 500,00	100,0	<b>250 000,00</b>
2	Фурье-спектрометр BRUKER Vertex 80V	п.29	Измерение транспортных свойств (осцилляции Шубникова - де Гааза) и оптических характеристик в терагерцовом диапазоне (фотопроводимость, циклотронный резонанс) гетероструктур при низких температурах.	5 000,00	80,0	<b>400 000,00</b>
<b>ВСЕГО стоимость НИР</b>					<b>180,0</b>	<b>650 000,00</b>

Зам.директора ИФМ РАН \_\_\_\_\_ Е.А.Девятайкина

Нач.ПЭО ИФМ РАН \_\_\_\_\_ А.И.Хусаинова

Руководитель НИР, к.ф-м.н. \_\_\_\_\_ С.В. Морозов